

产品描述

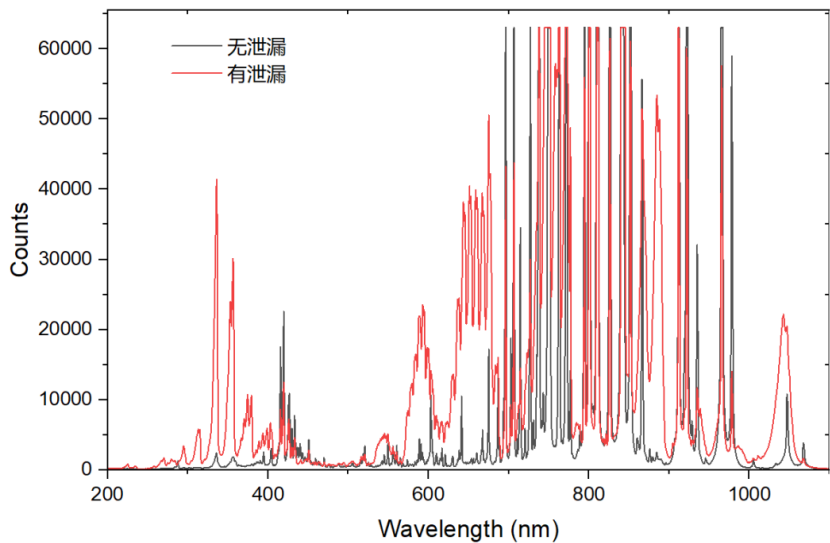
EPD-OES 发射光谱终点检测方案基于光学发射光谱法原理，通过分析刻蚀、腔室清洗、去胶等过程中反应物或生成物的特征光谱强度变化来判断是否到达刻蚀终点。方案可集成到等离子体加工设备上，作为监测和控制工艺过程的关键手段。采用模块化设计，根据客户使用需求配置单通道、双通道或多通道模式。

应用领域

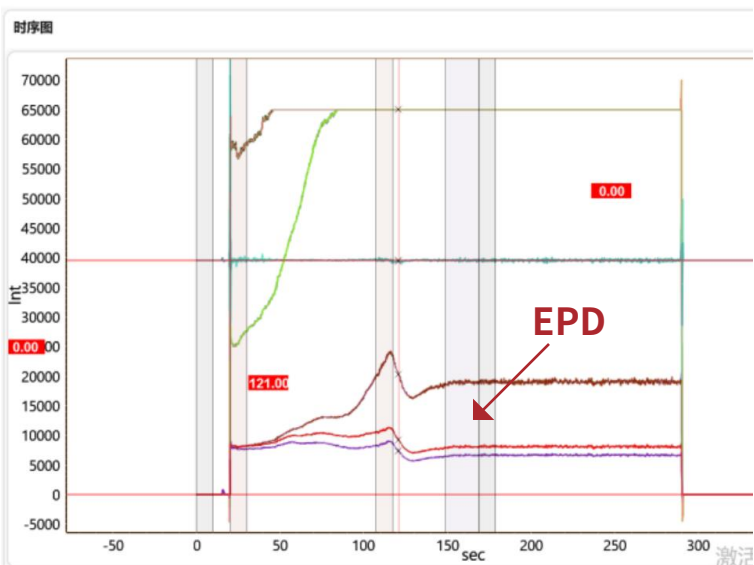
- PECVD 腔室清洗 EPD
- Dry Etch 刻蚀 EPD
- IBE 离子束刻蚀 EPD
- Strip 离子去胶 EPD
- 辉光发射反馈控制（PEM）

方案特点

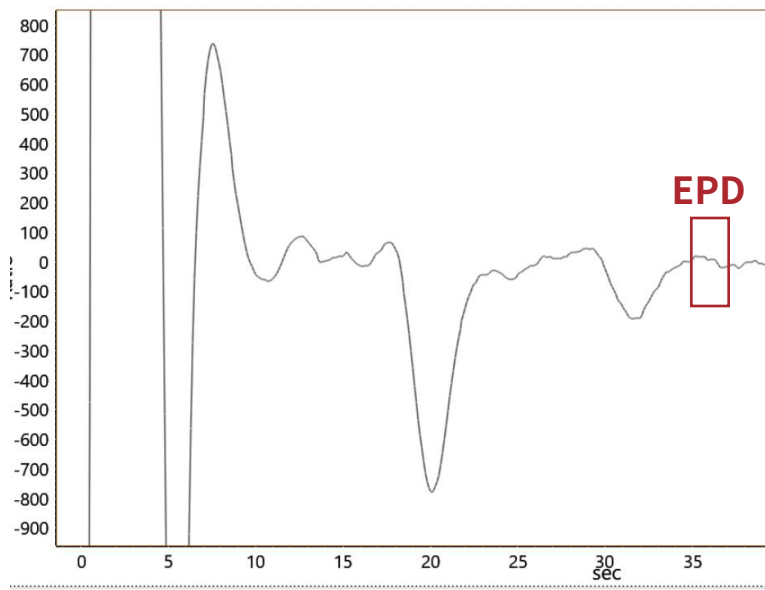
- 全波段检测分析
- 制程监控
- 内置多元算法，可同时测腔室 leak
- 流量反馈控制



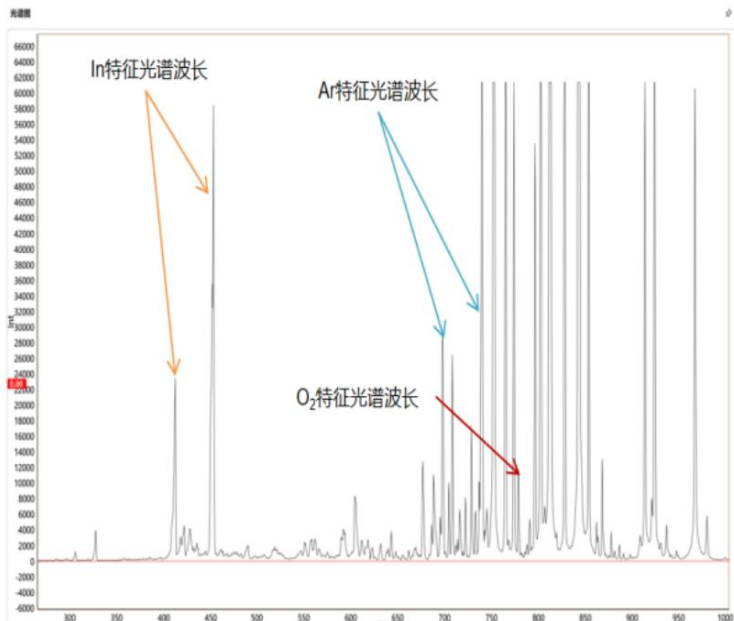
OES 用于腔体泄露在线监测



OES 用于 CVD 腔室清洗终点判断



OES 用于硅深孔刻蚀终点检测（开口率<2%）



OES 用于磁控溅射 ITO 薄膜 O2/In 含量监控

型号	XD XG 系列	XD X6000 系列	XD X2000 系列
制冷方式	制冷, 最低可达-25℃	非制冷	非制冷
探测器	进口CCD	进口CCD	进口CCD、CMOS
波段范围	350 - 1100nm (可定制)	200 - 1100nm (可定制)	220 - 1050nm (可定制)
分辨率	1.3nm@10μm狭缝 (可定制)	1.2nm@10μm狭缝 (可定制)	2.5nm@50μm狭缝 (可定制)
信噪比 (单次扫描)	1000 : 1	450 : 1	350 : 1
像素	1024	3648、2048 两种	2048
通讯方式	USB、网口	USB	USB
应用场合	开口率、高深宽比、超薄膜层刻蚀（极弱光）		常规膜层刻蚀、去胶、CVD 清洗 EPD、PEM